

第五章 磁介质

§ 5-1 磁介质及其磁化

§ 5-2 有磁介质时的恒定磁场

§ 5-3 磁场的边界条件



§ 5-1 磁介质及其磁化

- **磁性：**
 - 物质的基本属性之一，即物质的磁学特性
 - 吸铁石——天然磁体 —— 具有强磁性
 - 多数物质一般情况下没有明显的磁性
- **磁介质 (magnetic medium) :**
 - 对磁场有一定响应,并能反过来影响磁场的物质
 - 一般物质在较强磁场的作用下都显示出一定程度的磁性,即都能对磁场的作用有所响应, 所以都是磁介质
- **磁化 (magnetization) :**
 - 在外磁场的作用下, 原来没有磁性的物质, **变得**具有磁性, 简称磁化。磁介质被磁化后, 会产生**附加磁场**, 从而**改变**原来空间磁场的分布



§ 5-1 磁介质及其磁化

一、磁本质

1. 磁荷模型

- 磁荷有正、负，同号相斥，异号相吸
- 磁荷遵循磁的库仑定律（类似于电库仑定律）
- 定义磁场强度 H 为单位点磁荷所受的磁场力
- 把磁介质分子看作磁偶极子
- 认为磁化是大量分子磁偶极子规则取向使正、负磁荷聚集两端的过程，磁体间的作用源于其中的磁荷
- 但没有单独的磁极存在——？



§ 5-1 磁介质及其磁化

2. “分子电流”模型

安培的大胆假设

- 磁介质的“分子”相当于一个环形电流，是电荷的某种运动形成的，它没有像导体中电流所受的阻力，分子的环形电流具有磁矩——分子磁矩，在外磁场的作用下可以自由地改变方向

3. 现代的观点

分子电流 —— 卢瑟福行星模型

近代物理：量子化轨道 (n, l, m, m_s)

$$\vec{\mu}_l = -\frac{e}{2m} \vec{L} \qquad \mu_s = -\frac{e}{m} S_z$$



§ 5-1 磁介质及其磁化

- 分子磁矩 $\vec{p}_{m\text{分子}} = \vec{m}_l + \vec{m}_s$ (矢量和)
 - 轨道磁矩 \vec{m}_l : 由原子内各电子绕原子核的轨道运动决定
 - 自旋磁矩 \vec{m}_s : 由电子自旋与核自旋决定
- 所谓磁化:
 - 就是在外磁场 \vec{B}_0 作用下, 大量分子电流混乱分布 (无序) \rightarrow 整齐排列 (有序)
 - 每一个分子电流提供一个分子磁矩 $\vec{p}_{m\text{分子}}$
 - 磁化了的介质内分子磁矩矢量和 $\Sigma \vec{p}_{m\text{分子}} \neq 0$
 - 分子磁矩的整齐排列贡献宏观上的磁化电流 I' , 进而产生附加磁场 \vec{B}' , 总磁场 $\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$



§ 5-1 磁介质及其磁化

二、磁介质及其磁化

电介质 $\xrightarrow{\text{极化后}}$ 产生极化电荷 q'

$$\Rightarrow \text{介质中总场 } \vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$$

电介质中 \vec{E}' 总是与 \vec{E}_0 反向, 即恒有: $E < E_0$

磁介质 $\xrightarrow{\text{磁化后}}$ 产生磁化电流 I'

$$\Rightarrow \text{介质中总场 } \vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

磁介质中 \vec{B}' 与 \vec{B}_0 可能同向, 也可能反向, 即磁介质中可能有 $B > B_0$, 也可能是 $B < B_0$ 。

$$\mu_r = B / B_0$$

——磁介质的相对磁导率

$$\mu = \mu_r \mu_0$$

——磁介质的磁导率



§ 5-1 磁介质及其磁化

二、磁介质及其磁化

(1) 无外磁场时，物质在宏观上对外都不显磁性。在外磁场中，它们会表现出不同磁性。

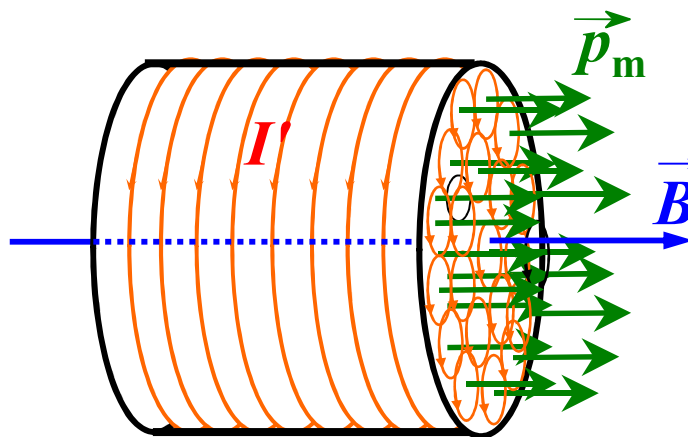
(2) 在外磁场 \vec{B}_0 作用下，

- 分子磁距受外磁场 \vec{B}_0 的磁力矩的作用,使分子磁距转向外磁场方向排列,则沿外磁场产生一**附加磁场 \vec{B}'** 。

$$\vec{p}_m \uparrow\uparrow \vec{B}_0$$

$$\vec{B}' \uparrow\uparrow \vec{B}_0$$

$$B = B_0 + B' > B_0$$





§ 5-1 磁介质及其磁化

- 外磁场 \vec{B}_0 使分子磁矩 \vec{P}_m 产生一个**附加磁矩** $\Delta\vec{p}_m$,
且 **$\Delta\vec{p}_m$** 的方向与外磁场 \vec{B}_0 方向相反。

\vec{p}_m 受到力矩作用

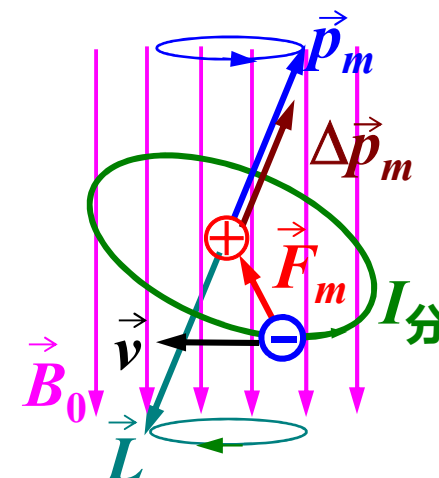
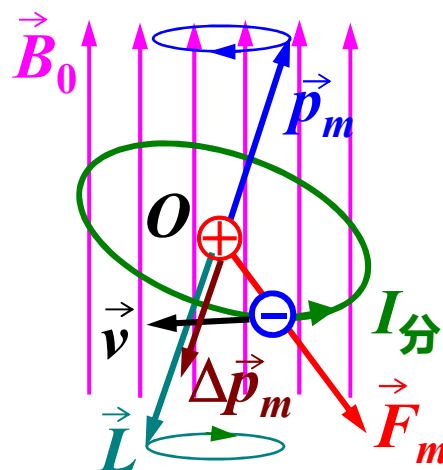
$$\vec{M}_o = \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{p}_m \times \vec{B}_0$$

$\Rightarrow e$ 进动 \Rightarrow 圆电流

$\Rightarrow \vec{B}' \updownarrow \vec{B}_0$

\Rightarrow 附加磁矩 Δp_m (恒与 \vec{B}_0 反向)

$$B = B_0 - B' < B_0$$





§ 5-1 磁介质及其磁化

1. 顺磁质：如锰，铬，氧等

对每个顺磁质分子： $\vec{p}_m \neq 0$ ，

外磁场中，每个分子磁矩都受到磁力矩作用：

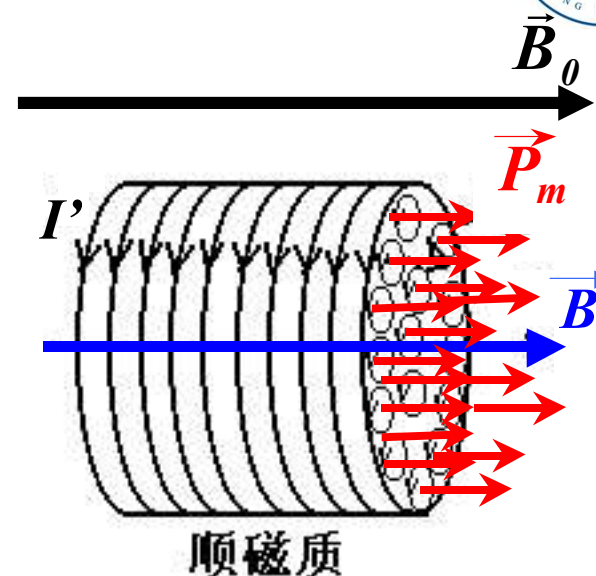
$$\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$$

有序排列的分子磁矩就产生一个**附加磁场 \vec{B}'** 。 \vec{B}' 与外场 \vec{B}_0 同向。

故有： $B = B_0 + B'$ ， $B > B_0$ ， $\mu_r = \frac{B}{B_0} > 1$

对顺磁质，附加磁矩 \ll 分子磁矩；

故分子磁矩产生附加磁场是顺磁质显示磁性的主要原因。





§ 5-1 磁介质及其磁化

2. 抗磁质 如水银，铜，氢等

在抗磁质中，每个分子的： $\vec{P}_m = 0$

只有在外磁场作用下产生的附加磁矩： $\Delta \vec{P}_m \neq 0$

电子进动产生的附加磁矩是抗磁质产生磁性的唯一原因。

另外，由于附加磁矩 $\Delta \vec{P}_m$ 的方向(即由于磁化而产生的附加磁感应强度 \vec{B}' 的方向)恒与外磁场的方向相反，所以抗磁质内部的 $B < B_0$ 。

即抗磁质的： $\mu_r = \frac{B}{B_0} < 1$

但在上述两类磁介质中，都有： $B \approx B_0$ 即 $\mu_r \approx 1$

且 $\mu_r = \text{const}$ (常量)，它们统称为弱磁质。



§ 5-1 磁介质及其磁化

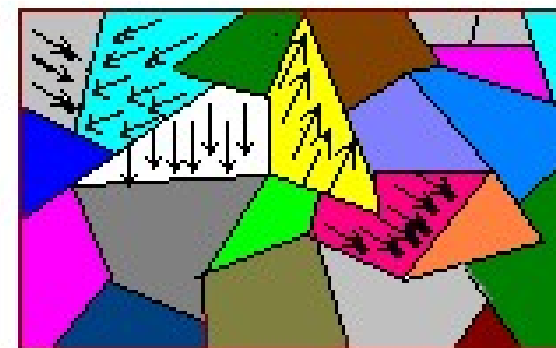
3. 铁磁质：固有磁矩为零 如铁，钴，镍等

磁畴：自发饱和磁化微区，

线度： $\mu\text{m} \sim \text{mm}$ ，

$\vec{B}_0 = 0$ 时，取向不同，

$\vec{B}_0 \neq 0$ 时， $\sum \vec{p}_m = 0$



磁畴变化时存在阻力 \Rightarrow 磁化不可逆, 磁滞, 剩磁

$T \uparrow \Rightarrow$ 磁畴内规则排列 $\downarrow \Rightarrow T > T_c$ 时顺磁

T_c 居里温度



§ 5-1 磁介质及其磁化

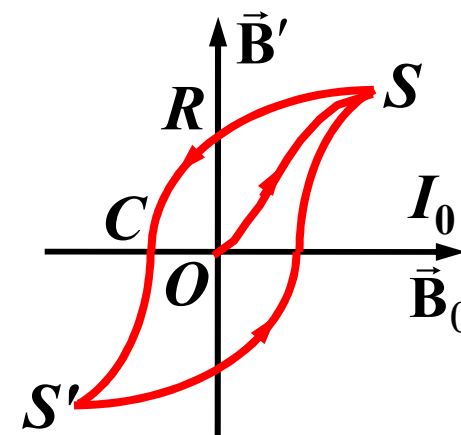
- \vec{B} 变化滞后于 I_0 或 $\vec{B}_0 \Rightarrow$ 磁滞回线

如图. $O \xrightarrow{I_0 \uparrow} S \xrightarrow{I_0 \downarrow} R \xrightarrow{I_0 < 0} C \xrightarrow{I_0 \downarrow} S' \rightarrow \dots \rightarrow S$

OS : 起始磁化曲线,

BR : 剩磁: 人造磁铁, 磁带, 磁盘等

磁滞回线的面积 \propto 功耗



按磁滞回线的形状, 铁磁质可分为

- { 软磁质: 磁头、交流电器铁芯等
- { 硬磁质: 永久磁铁 (天然 / 人造)

§ 5-1 磁介质及其磁化

铁磁材料的分类及其应用

• 软磁材料

- B_R 小, H_C 小, 磁滞回线瘦, 磁滞损耗小;
- 通电后立即磁化获得强磁场, 断电立即退磁。

磁头、交流电器铁芯等

• 硬磁材料

- B_R 大, H_C 大,
 - H_C : $10^4 \sim 10^6 \text{ A/m}$;
 - 磁滞回线胖, 磁滞损耗大;
 - 撤去外场后仍能保持强磁性
- 永久磁铁 (天然 / 人造)

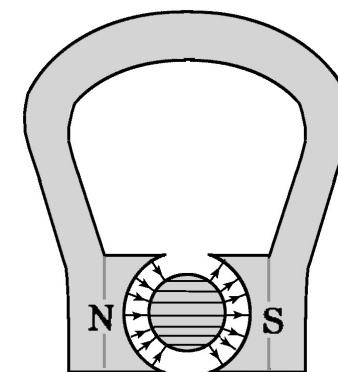
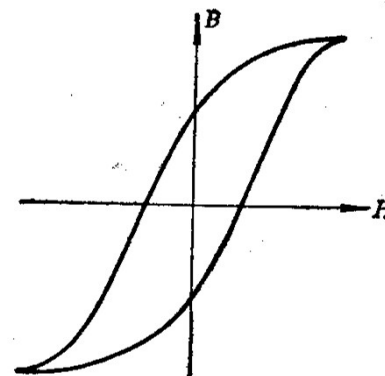
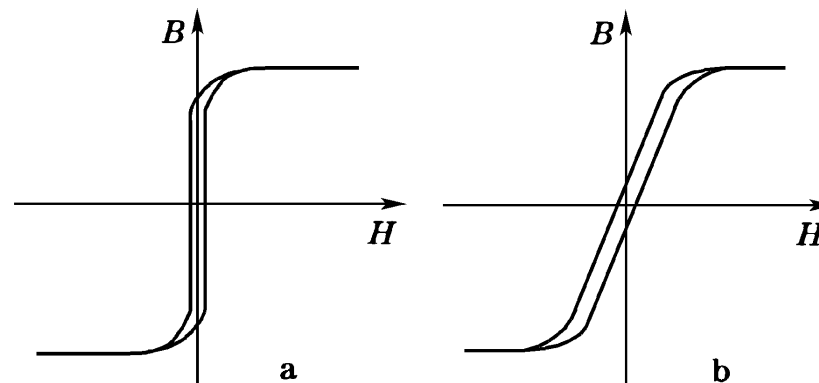


图 5-15 硬磁材料的磁滞回线



§ 5-1 磁介质及其磁化

磁性材料在信息技术中的应用

- 随着信息时代的到来，多种磁性材料在信息高新技术中获得广泛而重要的应用
- 磁记录：主要有(用永磁材料制成的)存储装置和写入、读出设备。存储装置包括磁头和磁记录介质

- **磁头：**
- 写入过程中：磁头将电信号——磁场
- 读出过程中：将磁记录介质的磁场——转变为电信号
- **磁记录介质：**内存、外存、磁盘和磁带等

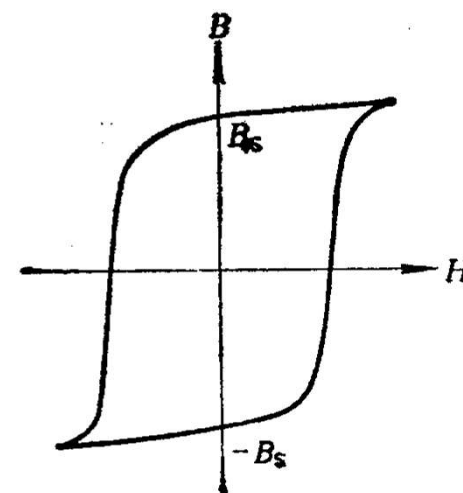


图 5-16 矩磁材料的磁滞回线



§ 5-1 磁介质及其磁化

三、介质磁化的宏观规律

类比电极化的讨论, 定义磁化强度:

$$\vec{M} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum_{\Delta V} \vec{p}_m}{\Delta V} \quad \text{或} \quad \vec{M} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum_{\Delta V} \Delta \vec{p}_m}{\Delta V}$$

$\vec{M} - I'$ 关系:

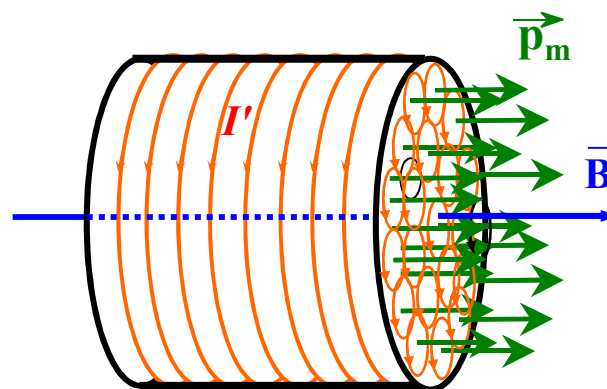
抗磁质

SI: A/m

I' 为所有未抵消的**分子电流代数和**, 与载流子无关, 称为磁化电流或**束缚电流**。

均匀磁介质:

内部各处小分子电流相互抵消; 表面未被抵消
→ 磁化面电流。







§ 5-1 磁介质及其磁化

可证：对任意闭合回路 L 有：

积分形式 $\oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = \sum_{L \text{ 内}} I'$ 通过以 L 为界 S 面内全部分子电流的代数和

↓ ↓

$\iint_S (\nabla \times \vec{M}) \cdot d\vec{S} = \iint_S \vec{j}_m \cdot d\vec{S}$ **微分形式**

→ $\nabla \times \vec{M} = \vec{j}_m$ 磁化电流密度

定义**磁化面电流密度 i'** ：垂直磁化面电流方向单位长度上的磁化面电流

可证 $\vec{i}' = \vec{M} \times \vec{n}^0$ 或 $i' = M_t$

\vec{n}^0 — 介质外法线单位矢量
 M_t — \vec{M} 在介质表面的切向分量

磁化面电流： $I' = i' l$



§ 5-1 磁介质及其磁化

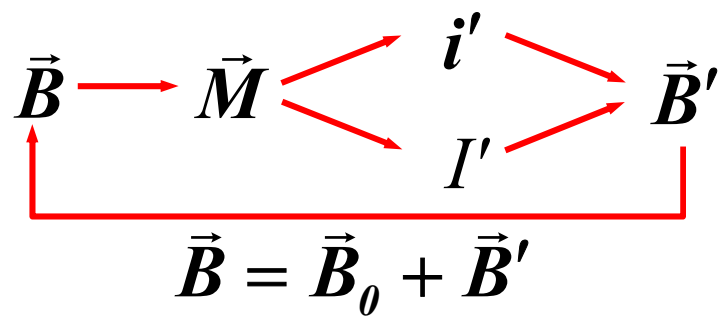
磁化电流与传导电流:

- **传导电流**
 - 载流子的定向流动，是电荷迁移的结果，产生焦耳热，产生磁场，遵从电流产生磁场规律
- **磁化电流**
 - 磁介质受到磁场作用后被磁化的后果，是大量分子电流叠加形成的在宏观范围内流动的电流，是大量分子电流统计平均的宏观效果
- **相同之处**：同样可以产生磁场，遵从电流产生磁场规律
- **不同之处**：电子都被限制在分子范围内运动，与因电荷的宏观迁移引起的传导电流不同；分子电流无热效应



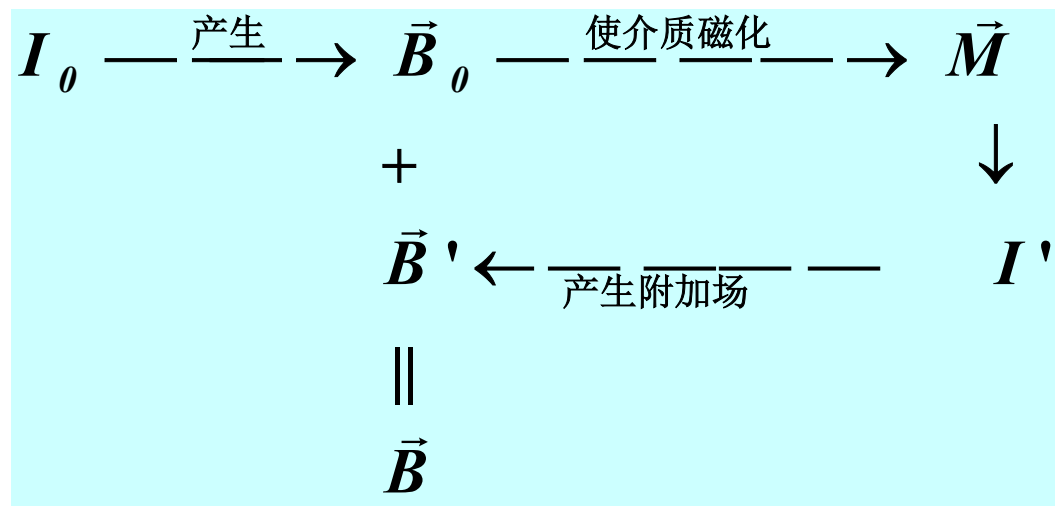
§ 5-1 磁介质及其磁化

求解时有类似电场的循环:





§ 5-2 有介质时的恒定磁场

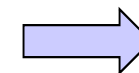


• 传导电流产生 + 磁化电流产生

$$\left\{ \begin{array}{l} \oiint_S \vec{B}_0 \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_L \vec{B}_0 \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L\text{内}} I_0 \end{array} \right.$$

+

$$\left\{ \begin{array}{l} \oiint_S \vec{B}' \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_L \vec{B}' \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L\text{内}} I' \end{array} \right.$$





§ 5-2 有介质时的恒定磁场

一. 总磁场遵从的规律

$$\left\{ \begin{array}{l} \oiint_S B \cdot dS = 0 \\ \oint_L B \cdot dl = \mu_0 \sum_{L \text{内}} I_0 + \mu_0 \sum_{L \text{内}} I' \end{array} \right. \quad \text{——磁介质中Gauss定理}$$

- 用上述公式计算磁场遇到麻烦
 - I' 和 B 互相牵扯，难于测量和控制，通常未知
 - B-S定律和安培环路定理以已知电流分布为前提
- 解决办法——需**补充**有关磁介质**磁化性质的已知条件**



§ 5-2 有介质时的恒定磁场

总场

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L\text{内}} I + \mu_0 \sum_{L\text{内}} I' \quad \longrightarrow \quad \sum I' = \oint \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{L\text{内}} I_0 + \mu_0 \oint \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

传导电流

$$\oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = \sum_{L\text{内}} I_0$$

引入
辅助
量：

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

磁场强度

有介质时的 Ampère
环路定理(H-ACL)：

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$$

归入所有磁化效应, 不必再求 \vec{M} 或 I' .



§ 5-2 有介质时的恒定磁场

二. 磁场强度

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \quad (\text{对任何磁质均适用})$$

弱磁质: $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$

$$\chi_m = \mu_r - 1 \text{ 为磁化率, } \Rightarrow \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0(1 + \chi_m)}$$

各向同性介质: χ_m 为标量, 有

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H} \quad \text{其中} \quad \mu = \mu_0 \mu_r$$

$\mu_r = 1 + \chi_m$ 是一般定义,

而 $\vec{B} = \mu_r \vec{B}_0$ 仅适用于磁介质充满整个磁场时.

真空中, $M=0$, $\chi_m = 0, \mu_r = 1$, $B = \mu_0 H$ 无磁化现象



§ 5-2 有介质时的恒定磁场

三. H-环路定理的应用

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

I_0 和均匀磁介质分布具有特定对称性时, 可用H-ACL求 \vec{H} 进而求 \vec{B} , \vec{M} , \vec{i}' 等量

即: $\left. \begin{matrix} I_0 \\ \mu_r \end{matrix} \right\} \text{对称性} \rightarrow \vec{H} \rightarrow \begin{cases} \vec{B} = \mu \vec{H} \rightarrow \Phi_m = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \\ \vec{M} = \chi_m \vec{H} \rightarrow \vec{i}' = \vec{M} \times \vec{n}^0 \end{cases}$



§ 5-2 有介质时的恒定磁场

例：充磁介质密绕螺线环. 已知 I, n, μ
求 $\vec{H}, \vec{B}, \vec{M}$ 和磁化分子电流 I' .

解： H 与磁芯物质无关

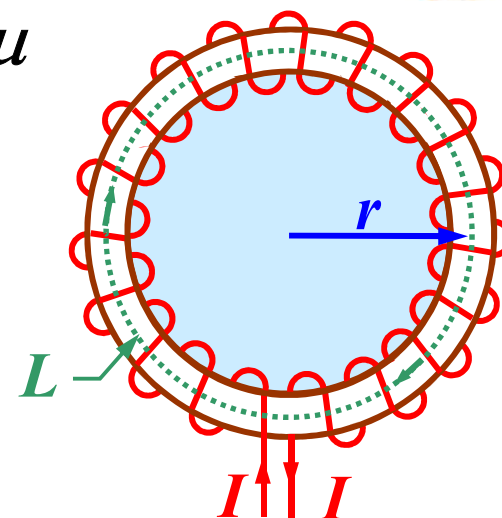
$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = n2\pi r I$$

$$H = nI; B = \mu nI \quad \text{方向: } \curvearrowright$$

$$M = \frac{B}{\mu_0} - H = \left(\frac{\mu}{\mu_0} - 1 \right) nI, \quad \text{方向: } \curvearrowright$$

$$i' = M \Rightarrow I'_{\text{等效}} = i'/n = \left(\frac{\mu}{\mu_0} - 1 \right) I$$

$\mu_r > 1$, 顺磁, $I_{\text{等效}}$ 与 I 同向. < 1 时 $I_{\text{等效}}$ 与 I 反向.





§ 5-2 有介质时的恒定磁场

例: 如图, 已知 $R_1, \mu_{r1}, R_2, \mu_{r2}, I(R_1)$.

求: ① \vec{H}, \vec{B} , ② $\vec{M}, \vec{i}'_{R_1}, \vec{i}'_{R_2}$

解: 半径 r 的同心圆上各点,

$|\vec{H}|, |\vec{B}|$ 相同, 方向与 I 成右旋

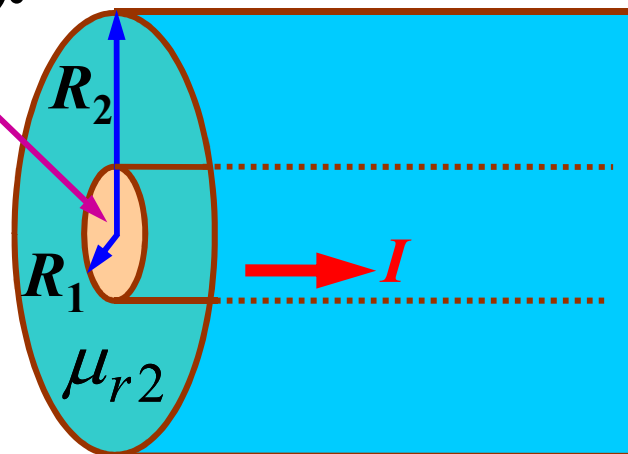
① $r < R_1$: $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = H 2\pi r = \frac{\pi r^2}{\pi R_1^2} I$

$$H = \frac{rI}{2\pi R_1^2}; B = \mu_0 \mu_{r1} H = \frac{\mu_0 \mu_{r1} rI}{2\pi R_1^2}, \text{ 与 } I \text{ 右旋}$$

$R_1 < r < R_2$: $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = H 2\pi r = I$

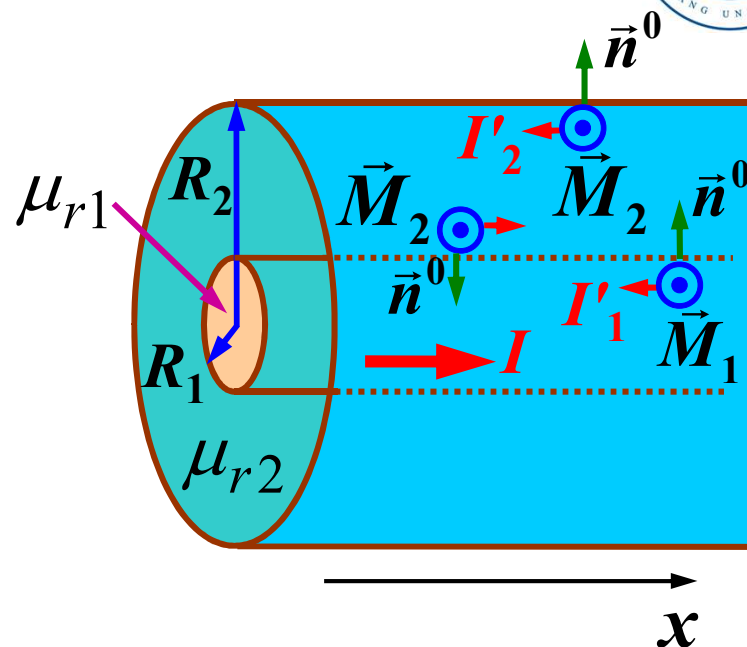
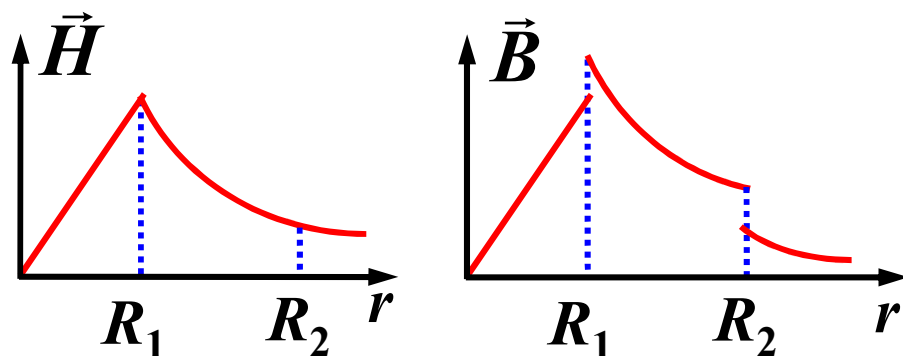
$$H = I / 2\pi r; B = \mu_0 \mu_{r2} I / 2\pi r \quad \text{方向同上}$$

$r > R_2$: $H = I / 2\pi r; B = \mu_0 I / 2\pi r$ 方向同上





§ 5-2 有介质时的恒定磁场



$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad \vec{M}_1 &= (\mu_{r1} - 1)\vec{H}_1 \\ &= (\mu_{r1} - 1)\frac{rI}{2\pi R_1^2}\vec{\theta} \end{aligned}$$

$$\vec{M}_2 = (\mu_{r2} - 1)\vec{H}_2 = (\mu_{r2} - 1)\frac{I}{2\pi r}\vec{\theta}$$

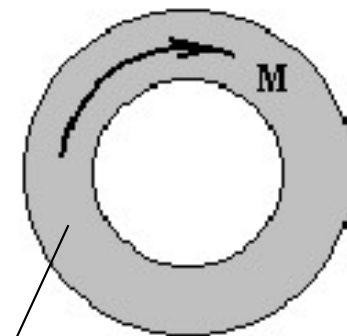
$$\vec{i}'_{R_1} = (\vec{M}_2 - \vec{M}_1)|_{R_1} \times \vec{n}^0 = \vec{i}(\mu_{r2} - \mu_{r1})I / 2\pi R_1$$

$$\vec{i}'_{R_2} = -\vec{M}_2|_{R_2} \times \vec{n}^0 = -\vec{i}(\mu_{r2} - 1)I / 2\pi R_2$$



§ 5-2 有介质时的恒定磁场

- 例：有一磁介质细铁环，在外磁场撤消后，仍处于磁化状态，磁化强度矢量 \vec{M} 的大小处处相同， \vec{M} 的方向如图所示。求环内的磁场强度 \vec{H} 和磁感应强度 \vec{B}



- 问：公式 $\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$ 是否适用？
- 答：**不适用**，因为铁环属于铁磁质
- 可以用 $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$ 来讨论
- 方法一：用 \vec{H} 的安培环路定理
求 \vec{H} — \vec{M} — \vec{B}
- 方法二： \vec{M} — \vec{I}' — \vec{B} — \vec{H}

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0 = 0$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{M}$$

$$\vec{i}' = \vec{M} \times \vec{n} \quad i' = nI$$

与螺绕环类比

\vec{B} 和 \vec{M} 方向一致为

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} = 0$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{i}' = \mu_0 \vec{M}$$



§ 5-3 磁场的边界条件

- **要点：**
 - **界面上介质的性质有一突变，这将导致磁场也会有突变**
 - **必须考虑用新的形式来给出边界上各物理量的关系，亦即给出边界条件**
 - **磁场的高斯定理、环路定理的积分形式在边界上依然成立，可以把不同介质的场量用积分方程联系起来**
 - **实际上边界条件就是把积分方程放到边界突变处得到的结果**

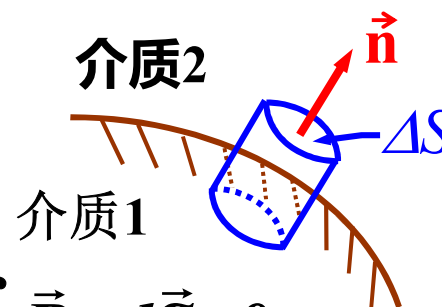


§ 5-3 磁场的边界条件

在两种磁介质分界面上

• 由磁高斯定理可得: **B法向连续**

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_{\text{底}1} \vec{B} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{底}2} \vec{B} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{侧面}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$
$$- B_{1n} \Delta S \quad B_{2n} \Delta S$$



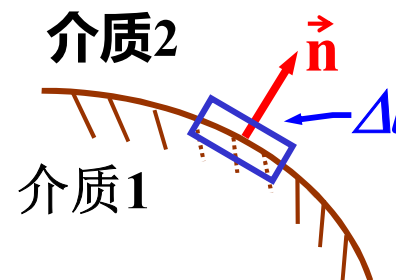
侧面积 $\rightarrow 0$

$$(\vec{B}_2 - \vec{B}_1) \cdot \vec{n} = 0 \quad \text{或} \quad B_{2n} = B_{1n}$$

设界面上无传导电流, 则

• 由环路定理可得: **H切向连续**

$$\vec{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = 0$$





§ 5-3 磁场的边界条件

磁感应线在边界上的“折射”

B法向分量连续，切向分量不连续，在两种界面发生折射

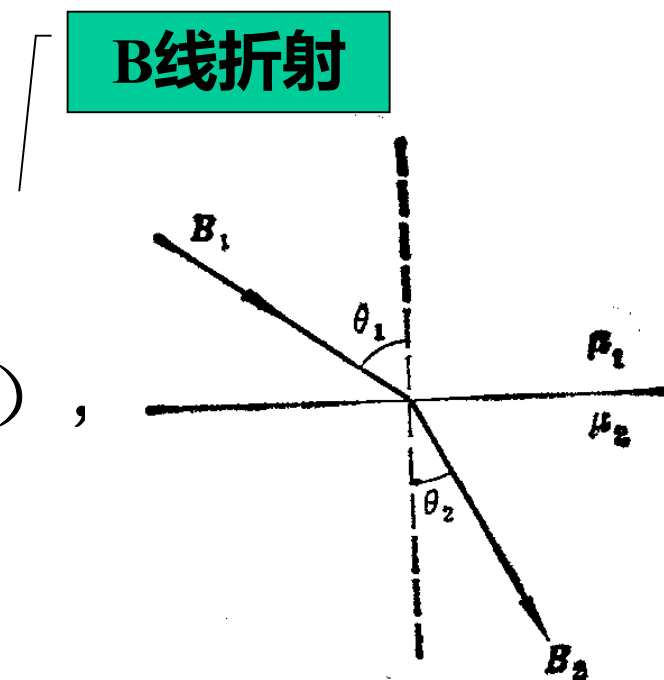
$$\frac{\operatorname{tg} \theta_1}{\operatorname{tg} \theta_2} = \frac{B_{1t}}{B_{2t}} = \frac{\mu_1 H_{1t}}{\mu_2 H_{2t}} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$$

若 $\mu_2 = \mu_0$ (真空或非铁磁材料) ,

$\mu_1 \gg \mu_0$ (铁磁质) , 则

$$\theta_1 \approx 90^\circ, \quad \theta_2 \approx 0$$

即铁磁质B线几乎与分界面平行——磁屏蔽



§ 5-3 磁场的边界条件

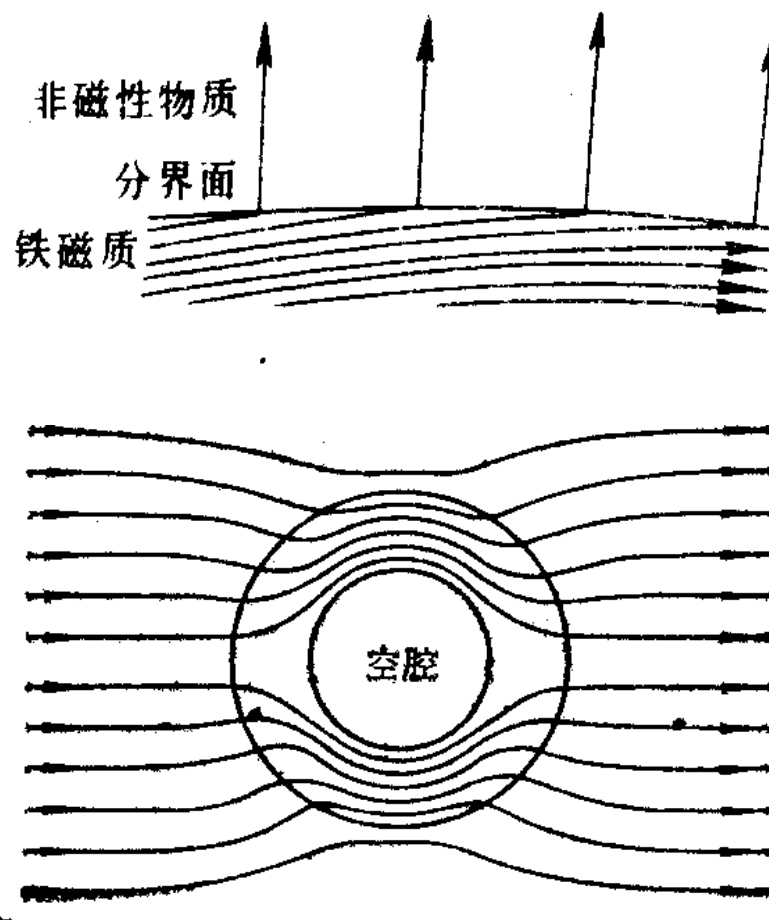


图 5-21 磁屏蔽

磁屏蔽效果没有静电屏蔽好



课后作业

课后习题：

5.1, 5.3, 5.5, 5.6

截止日期： 2025-06-10 24:00



谢谢!